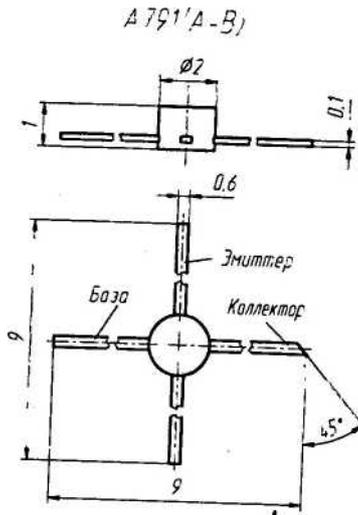


A791A, A791B, A791B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения в малошумящих усилителях на частотах 2...7,2 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем, микросборок, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, пониженного и повышенного давления и солнечной радиации. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой: A791A — белой, A791B — зеленой, A791B — коричневой. Тип прибора указывается в этикетке.



Масса транзистора A791A не более 0,02 г, A791B, A791B не более 0,05 г. Диаметр 0 2 мм для A791A, 0 3 мм для A791B, A791B.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее . 20

Коэффициент шума на $f = 2,25$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 3$ мА, не более:

A791A, A791B.....	2 дБ
A791B.....	6 дБ

Коэффициент усиления по мощности на $f = 2,25$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 3$ мА, не менее:

A791A, A791B.....	8 дБ
A791B.....	10 дБ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В, не более	0,4 мкА
Обратный ток эмиттера при $I_{3э} = 1$ В, не более	15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	10 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база..	1 В
Потенциал статического электричества.....	30 В
Постоянный ток коллектора	8,5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T = -60...+85$ °С	70 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода.	+200 °С
Температура окружающей среды	—60...+125 °С

¹ При $T > +85$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно до 35 мВт при +125 °С.

Минимальное расстояние от кристаллодержателя до места пайки вывода 2 мм, температура пайки не выше +265 °С, время пайки не более 4 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя, температура пайки +260 °С, время пайки не более 3 с. При этом следует пользоваться серебряно-индиевыми и другими припоями, не приводящими к возникновению интерметаллических соединений. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 0,2 мм от кристаллодержателя при температуре пайки не выше +160 °С, время пайки не более 10 с.

Допускается однократный изгиб вывода с радиусом закругления 1,5 мм от кристаллодержателя. Допускается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

Материалы выводов: лента ДПРНТ 0,1 на НП2 по ГОСТ 2170—73, покрытие Н1, ЗлЗ.

При эксплуатации транзисторов в усилительных схемах следует учитывать возможность их самовозбуждения, как высокочастотных элементов и принимать меры к его устранению.